

Характеристики наборов биполярных транзисторов

I_{CBO}	Обратный ток коллектора	Δh_{21E}	Разброс статических коэф. пер. тока
I_{EBO}	Обратный ток эмиттера	U_{BESAT}	Напряжение насыщения база-эмиттер
I_{TIT20}	Ток утечки между транзисторами	U_{CESAT}	Напряжение насыщения коллектор-эмиттер
h_{21E}	Стат. коэф. пр. пер. т. в сх. с общ. эм. в реж. бол. сиг.	ΔU_{BE}	Разброс напряжения база-эмиттера

Тип	Параметр								Тип корпуса	Технические условия	Аналог	Функциональное назначение	Диапазон рабочих температур	Кол-во транзисторов	
	I_{CBO} , нА	I_{EBO} , нА	h_{21E}	I_{TIT20} , нА	Δh_{21E}	U_{BESAT} , В	U_{CESAT} , В	ΔU_{BE} , В							
198НТ1А	<50	<100	30-200	<50	<15	<0,8	<0,2	3	401.14-5	АЕЯР.431410.245ТУ	СА3046	Матрица транзисторо в NPN типа	-60 -; +125	5	
198НТ1Б			50-250					10							
198НТ1В			30-200					3							
198НТ2А			30-200					<0,1							10
198НТ2Б			30-200					-							
198НТ3			30-200					-							
198НТ5А	<75	30-250	<50	<15	<0,85	<0,5	<0,75	5			СА3084	Матрица транзисторо в PNP типа	-60 -; +125	4	
198НТ5Б	<100														<0,75
198НТ6А	<75														<0,5
198НТ6Б	<100														<0,75
198НТ7А	<75														<0,5
198НТ7Б	<100														<0,75
198НТ8А	<75								<0,5						
198НТ8Б	<100								<0,75	-					3